

H – Personální zabezpečení - přednášející						
Název VŠ / součásti	Technická univerzita v Liberci					
Název SP	Nanotechnologie					
Jméno a příjmení	Eduard Hulicius				Tituly	Doc. Ing. CSc.
Rok narození	1948	typ vzt.	externí	rozsah	dohoda	do kdy
Další současní zaměstnavatelé				typ prac. vztahu		rozsah
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.				hlavní		100 %
Přednášky v předmětech						
Kapitoly o nanostrukturách (podíl na přednáškách, organizace), Příprava polovodičových nanostruktur						
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP						
Ing. - KIPL, FJFI-ČVUT CSc. - ÚFPL ČSAV						
Zaměstnání - FZÚ AV ČR, v. v. i. (dříve ÚFPL ČSAV, FZÚ ČSAV, FZÚ AV ČR), 1973 – dosud						
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let						
Od r. 2004 24 článků v mezinárodních impaktovaných časopisech; 3 další recenzované články; 1 kapitola v monografii; 3 Invited, 51 Internat. a 18 Nat. konferenčních příspěvků ve sbornících, 0 patentů.						
Vybrané publikace:						
D.Kindl, J.Toušková, E.Hulicius, J.Pangrác, T.Šimeček, Z.Výborný, P.Hubík, J.J.Mareš, J.Křištofik, Influence of growth rate on charge transport in GaSb homojunctions prepared by MOVPE, J. Appl. Phys. 95 (2004) 1811-1815						
S.Civiš, V.Horká, T.Šimeček, E.Hulicius, J.Pangrác, J.Oswald, O.Petříček, Y.Rouillard, C.Alibert, R.Werner, GaSb based lasers operating near 2.3 μm for high resolution absorption spectroscopy, Spectrochimica Acta Part A 61 (2005) 3066-3069						
K.D.Moiseev, A.P.Astakhova, G.G.Zebrya, M.P.Mikhailova, Yu.P.Yakovlev, E.Hulicius, A.Hospodkova, J.Pangrác, K.Melichar, and T.Šimeček, Electroluminescence of AlSb/InAsSb/AlSb quantum well heterostructure grown by MOVPE, Appl. Phys. Lett. 88 (2006) 132102-1 - 132102-3						
V.Krápek, K.Kuldová, J.Oswald, A.Hospodková, E.Hulicius, J.Humlíček, Elongation of InAs/GaAs quantum dots from magnetophotoluminescence measurements, Appl. Phys. Lett. 89 (2006), 153108						
F.Dubecký, E.Hulicius, S.Franchi, A.Perďochová-Šagátová, B.Zat'ko, P.Hubík, E.Gombia, P.Boháček, J.Pangrác, and V.Nečas, Performance study of radiation detectors based on semi-insulating GaAs with P+ homo- and heterojunction blocking electrode, Nuclear Instruments and Methods A 563 (1), (2006) 159-162P						
Hazdra, J.Voves, E.Hulicius, J.Pangrác, and Z.Šourek, Ultrathin InAs and Modulated InGaAs Layers in GaAs Grown by MOVPE Studied by Photomodulated Reflectance Spectroscopy, Appl. Surf. Science 253 (1) (2006) 85-89						
J. Walachová, J. Zelinka, V. Malina, and J. Vaniš, F. Šroubek, J. Pangrác, K. Melichar, and E. Hulicius, Study of InAs quantum dots in AlGaAs/GaAs heterostructure by ballistic electron emission microscopy/spectroscopy, Appl. Phys. Lett. 91 (2007) 042110						
J. Walachová, J. Zelinka, V. Malina, and J. Vaniš, F. Šroubek, J. Pangrác, K. Melichar, and E. Hulicius, Ballistic electron emission spectroscopy/microscopy of self-assembled InAs quantum dots of different sizes embedded in GaAs/AlGaAs heterostructure, Appl. Phys. Lett. 92 1 (2008) 012101-1						
[51]P. Hazdra, J. Oswald, M. Atef, K. Kuldová, A. Hospodková, E. Hulicius, and J. Pangrác, InAs/GaAs quantum dot structures covered by InGaAs strain reducing layer characterized by photomodulated reflectance, Mat. Sci. Eng. B 147 (2008) 175-178						
[53] E.Hulicius, J.Oswald, J.Pangrác, J.Vyskocil, A.Hospodková, K.Kuldová, K.Melichar, and T.Šimeček, Growth and properties of InAs/InxGa1-x As/GaAs quantum dot structures, J. Cryst. Growth, (2008), doi:10.1016/j.jcrysgro.2007.11.055						
Působení v zahraničí						
1977 FIAN, Moskva – 3 měsíce, v letech 1976 – 2004 FTI Petrohrad – celkem asi 6 měsíců						
1986 Univ. of Alberta – 4 měsíce						
desítky konferencí a krátkodobých pobytů – Evropa, USA, Japonsko, Indie, Austrálie, Kanada						
Obor habilitačního nebo jmenovacího řízení nebo vědecké hodnosti	nebo udělení				řízení na VŠ	
	Aplikovaná a experimentální fyzika – CSc. Elektronika a lékařská technika – doc.				ČVUT	
Rok udělení (prof...)	2005				ohlasy publikací	
					mezinár.	tuzem.
Podpis přednášejícího					175	nesled.
					datum	30.4.2008